


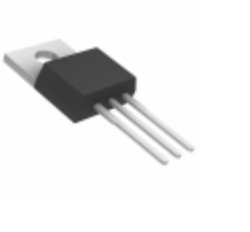
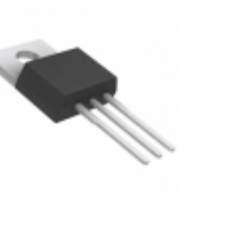



	<h2 style="color: red;">FDP150N10</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP150N10</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 57A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP150N10.pdf 2.FDP150N10.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 36205 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP150N10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 57A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	36205 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 57A (Tc) 110W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	57A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 49A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4760pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP150N10 ist neu im Original, Suche FDP150N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP150N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP150N10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP14AN06LAO FAI FDP14AN06LAO FAI</p>	 <p>FDP150N10A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 50A TO-220-3</p>	 <p>FDP14AN06LAO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 67A TO-220AB</p>	 <p>FDP150N10A-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 50A TO-220-3</p>
 <p>FDP150N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 50A TO-220-3</p>	 <p>FDP15N10 FSC FSC TO-220</p>	 <p>FDP150N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP150N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDP14N60 FSC FDP14N60 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP100N10	↔ FDP10AN06A0	⇒ FDP10AN06A0	D FDP10AN06A0	↗ FDP10N60NZ
⊣ FDP10N60NZ	⊗ FDP120AN15A0	D FDP120AN15A0	⇒ FDP120AN15A0	↗ FDP120N10
⊗ FDP120N10	⊣ FDP12N50	⊗ FDP12N50	↔ FDP12N50NZ	↗ FDP12N50NZ
D FDP12N60NZ	⊗ FDP12N60NZ	⊣ FDP13AN06A0	⊗ FDP13AN06A0	↗ FDP13AN06A0
⇒ FDP14AN06LAO	↔ FDP14AN06LAO	⊗ FDP14AN06LAO	⊣ FDP14N60	↗ FDP150N10
↔ FDP150N10A	⇒ FDP150N10A	D FDP150N10A_F102	⊗ FDP15N40	⊣ FDP15N40
⊗ FDP15N50	D FDP15N50	⇒ FDP15N65	↔ FDP15N65	↗ FDP16AN08A0
⊣ FDP16AN08A0	⊗ FDP16AN08A0	↔ FDP16AN098A0	⇒ FDP16N50	↗ FDP16N50
⊗ FDP16N50-0704	⊣ FDP18N20F	⊗ FDP18N20F	D FDP18N20V2	↗ FDP18N50
↔ FDP18N50	⊗ FDP19N40	⊣ FDP19N40	⊗ FDP20AN06A0	↗ FDP20AN06A0

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited